

平成29年度 公益社団法人 応用物理学会 北陸・信越支部 講演会

入場
無料

日時 平成29年11月15日(水) 10:30 ~ 11:30

場所 金沢大学 角間キャンパス・南地区

自然科学本館 2階 203講義室

(石川県金沢市角間町)

演題 ミストCVD法を用いた酸化物薄膜の形成

講師 中村 有水 先生

(熊本大学大学院 自然科学研究科

情報電気電子工学専攻)

講演内容:

ミストCVD法では、水溶液等を原料とし超音波でミスト化し、大気圧の成膜室に送り込むだけの簡易な装置構成であるため、危険性も少なく、低コストで酸化物薄膜を形成できる。

我々は、酸化亜鉛、酸化スズ、酸化銅等の酸化物、さらには硫化亜鉛等の硫化物に関しても、エピタキシャル成長を実現した。また、通常のみストCVD装置の弱点である膜厚均一性においては、高速回転式のみストCVD装置を独自に開発し、膜厚均一性2%以内の高均一な単結晶薄膜を得る事に成功している。現在は、酸化亜鉛を用いた、大気圧成膜では初のLED実現に向けて研究を行っている。

問い合わせ先 川江 健 金沢大学 理工研究域

TEL:076-234-4881, e-mail: kawae@ec.t.kanazawa-u.ac.jp